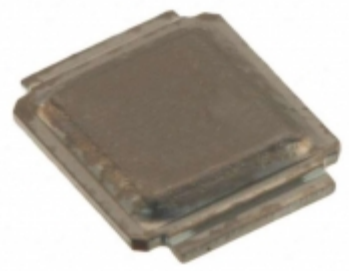

	<h2 style="color: red;">BSB013NE2LXI</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	BSB013NE2LXI
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	BSB013NE2LXI Infineon Technologies
Datenblätter:	 BSB013NE2LXI.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 18407 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	BSB013NE2LXI
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	BSB013NE2LXI Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	18407 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	3-WDSO
Supplier Device-Gehäuse	MG-WDSO-2, CanPAK M™
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta), 57W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	36A (Ta), 163A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.3 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	62nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4400pF @ 12V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

BSB013NE2LXI ist neu im Original, Suche BSB013NE2LXI Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BSB013NE2LXI International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BSB013NE2LXI: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>BSB013NE2LXIXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 163A WDSO-2</p>	 <p>BSB014N04LX3GCT-ND INFINEON INFINEON MG-WDSO</p>	 <p>BSB012N03LX3 G International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 180A 2WDSO</p>	 <p>BSB014N04LX3GXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 180A 2WDSO</p>
 <p>BSB012NE2LXI International Rectifier (Infineon Technologies) BSB012NE2LXI INFINEON</p>	 <p>BSB012NE2LX International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 170A WDSO-2</p>	 <p>BSB012NE2LX5G INFINEON BSB012NE2LX5G INFINEON</p>	 <p>BSB014N04LX3 G International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 180A 2WDSO</p>

heiße Teile

Mehr

06031A510GAT2A	2DB1694-7	744066100	AIF50BS355	AMS1084CM-5.0
AT89C51ED2-IM	BSB012NE2LX	BSB012NE2LX5G	BSB012NE2LXI	BSB014N04LX3G
BSB015N04NX3G	BSB017N03LX3G	BSB018NE2LXG	BSB019N03LXG	BSB024N03LXG
BSB028N06NN3G	BSB053N03LPG	BSB053N03LTG	BSB056N10NN3G	BSB104N08NP3G
BSB105N04NX3G	BSB165N15NZ3G	BSC042NE2SXT	BZB84-C75	CC1206KKX7RZBB471
DS1104SG26	EMIF02-SPK03F2	EP3C10F256C8N	FAN53528BUC08X	FM75HA-H
GRM0335C1H430GA01D	HSR412SR2M	HW-108A-D	IXSN80N60AU	LM4040DIM3-10.0
MCP6491T-E/OT	MTC130A1600V	P270CH02FN0	PESD24VL1BA/DG/B2	PMF3800SN
PSCA101303	QM200HA-2H	SI9955DY-T1-E3	SKKL570/16E	SMLJ60S8-TP
SPH05-10R	STF10NK50Z	THS4271DR	TPS65921BZQZR	V24A48E300BG

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited